Γ		Формат	Зана	Паз.	Обозн	חטטט	IIΩ	Наименован	םוי	Кол.	Приме-
		ϕa	36		UUUSH			TIUUTEHUUUNI	<i></i>	X	Yahue
į,	примен.							//			
4	.C. 1011							<u>Документац</u>	<u>ИЯ</u>		
	dal I	A2			NY4.11.03.03.25.	06.62	2.4 <i>5.001 </i>	Схема электриче	СКОЯ	1	
								, принципиальная			
F		A2			ИУ4.11.03.03.2.	5.06.	62.45.002	Плата печатная		1	
		A2			ИУ4.11.03.03.25.	06.62	2.45.001 СБ	Сборочный черте	' <i>X</i> '	1	
								электронной яче			
OI V	2/	A4			ИУ4.11.03.03.25.U	76.62.	4 <i>5.001 </i>	Перечень элемені	ПОВ	1	
9000	npao.										
	7							7			
								<u>Детали</u>			
L				1	1/11/ 11/02/02/2	<u>ΓΩ</u>	(2/5002	Паата воиатиаа		1	
<i>)</i> ;				/	V194.11.U3.U3.Z.	<i>D.UD.</i> (02.43.002	Плата печатная		/	
Защищены								Прочие дета			
paga sau								<u> </u>	<u> </u>		
Bre npa	סמונומ							Диоды			
B RUT.	7			2				1N4002 1A 100B		7	VD2, VD3,
", Россия. Подо	701/							(Diotec Semiconductor, i	Германия)		VD4, VD5,
истемы проектирования", и.е. в в в в в в в в в в в в в в в в в в	.WG							,			VD6, VD7,VD8
אמרותאי	יים מלו			3				1N4 148 150MA 10l	OB .	15	<i>VD1, VD10,</i>
300U 100E) 							(Diotec Semiconductor, i	Германия)		VD11, VD12,
MUTTEM	2										VD13, VD14,
\sim	UHD.										VD15, VD16,
000 "ACKOH-	3CIM.										<i>VD17, VD18,</i>
77 OO 72											VD19, VD20,
070	ממונומ										VD21, VD22,
E II	, U 0,		Ш								<i>VD23</i>
ACA BE	/ Jadr			+			1144	4.11.03.03.25.0	K 624	5/	1 <i>01</i>
3 4HZ	 		! /luu 3paò		№ докум. Подп. оветников М.М.	Дата	7121			J.C Nucm	Листов
-30 v23 Учедния версия © 2024	, NOO,	Πρι			- еливанов К.В.		Охрана квар	тиры с оповещением		1	4
7/AC-	V. //	Н.КОНТР. ПО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНЦ						•	MITY L	Баумана ИУ4	
	le ∂na i	<i>Ут</i>	В.		п использования		Копиров	<i>'</i>	Груг	nna 'N5 1110 mam	<u>14-625</u> A4

	Формат Зоца	טטטט	/103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
					<u>Конденсаторы</u>		
		4	4		<i>JYM1H104KBX020000B</i>	2	[3, [6
					(JB Capacitors, Тайвань)		
		1	5		JRB2E100M05001000170000B	3	[1, [2,
					(JB Capacitors, Тайвань)		<i>C5</i>
		1	5		JYM1H4 72KBX010000B	2	[4, [8
					(JB Capacitors, Тайвань)		
			7		JYM1H105MBF020000B	1	<i>C7</i>
					(JB Capacitors, Тайвань)		
	\vdash				Микросхемы		
		+	8		<u> </u>	3	DD1, DD_
		+			וו טכוווו טכוווו טכוווו טכוווו טכוווו		DD4
<i>)</i> ;		†	9		K561/IH2 (8K0.348.457-12TY)	1	DD2
HOUTHBA		Ŧ	10		K561NE11 (δK0.348.457–13TY)	1	DD5
таба элцицены та		1	11		K561/IE6 (δK0.348.457-05TY)	1	DD6
Ысе пра и дата		1	12		K561NE10 (δK0.348.457-04TY)	1	DD7
Рассия Вс Подп. и .			13		K561K172 (BK0.348.457-17TY)	1	DD8
1000 1001		1	14		Оптопара тиристорная	1	VD9
N° de					A0Y103B1 (YX0.336.062TY)		
итемы проектиродания, No Инв. No дибл.			45				GL /A
No		1	<i>15</i>		Переключатель П2К-Н-1-2	1	SW1
NUTL		1	4.4		(FOCT 15150-69)		
UUU AL B3am.		1	16		Предохранитель Н520РТ 1А 250В	1	FU1
3 1 —	1	\bot			(RUICHI, Kumaū)		
я © 2024 дата	igwdapped	+	17		// T		14
70. U. L	$\vdash \vdash$	4	¹⁷ —		Наборное поле DS1021-2*10SF11-B	1	<i>J1</i>
50 VZ3 Учедная берсия Nº подл. Подп. и о	$oxed{+}$	+			(Connfly Electronic, Kumaū)		
	$\parallel \parallel$	\dagger			<u>Разъемы</u>		
1AK-3L 9. Nº 1	广	•		IAU	4.11.03.03.25.06.62.45.		7.1 /lucn
MHC	Изм. /		020 UCNO∕IЬ.	кум. Подп. Дата	4. 11.U.J.U.J.Z.J.UO.OZ.4.J. Ipoban Фор		A4 2

	Фармат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	ϕ	1	18		KLS2-300-5.00-02P-2S	2	XS1, XS2
	$ \cdot $				(KLS electronic co ltd, Kumaū)		7131, 7132
	H		19		DS1021-1*2SF11-B	1	XP1
					(Connfly Electronic, Kumaū)		,,,,
	H						
					<i>Резисторы</i>		
			20		CF-25 2MOM 0,25Bm 5%	3	R1, R6,
					(Үадео, Тайвань)		R21
			21		CF-25 56kOm 0,25Bm 5%	6	R2, R16,
					(Үадео, Тайвань)		R17, R18
							R19, R20
			22		CF-25 8200m 0,5Bm 5%	1	R3
					(Үадео, Тайвань)		
			23		CF-25 1kOm 0,25Bm 5%	1	R4
					(Yageo, Тайвань)		
			24		CF-25 5.6kOm 0,25Bm 5%	1	<i>R5</i>
ша					(Үадео, Тайвань)		
и дат			25		CF-25 4.7kOm 0,25Bm 5%	1	<i>R7</i>
<u> 1911. L</u>					(Үадео, Тайвань)		
7/			26		CF-25 6.8kOm 0,5Bm 5%	4	R8, R10,
lδn.	Ш				(Үадео, Тайвань)		R12, R14
Nº dı			27		CF-25 2kOm 0,25Bm 5%	1	<i>R9</i>
Инв.	Ш				(Үадео, Тайвань)		
№ Инв. № дцъ́л.			28		CF-25 5600m 0,25Bm 5%	1	R11
UHD.					(Үадео, Тайвань)		
Взам			29		CF-25 820k0m 0,25Bm 5%	1	R13
9	Ш				(Үадео, Тайвань)		
дата	\coprod		30		CF-25 1MOm 0,25Bm 5%	1	R15
. u đ	\coprod				(Үадео, Тайвань)		
<u>Nodn.</u>	Ц						
	Ц		31		Светодиод GNL-3012HD 60° d=3мм	1	HL1
подл.					5-10мКд 700нМ ((G-nor Electronics, Kumaū))		
B. No				IAU	4. <i>11.03.03.25.06.62.45.</i>		7 <i>1</i> /luci
MHL	Изм.	Λυα	TITI Nº D	докум. Подп. Дата	4.11.02.02.23.00.02.43.	UU	// 3

	Формат	Зона	<i>Na3.</i>		Обознач	PHIP	,	Наименова		Кол.	Приме-
	ϕ	Ŝ						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			YOHUE
			32					Тиристор ВТ151-800	PR 12A 800B	1	VS1
								(Weida Heavy Indus	try, Kumaū)		
	_		77					<u>Транзиста</u>	<u>ОРЫ</u> ОС 24 СТИ	7	1/74 1/72
			33					KT940A (aA0.33	86.246 9/	3	VT1, VT2, VT3
			34					КТ361Г (ФЫО.33	26 201TY)	1	V73 V74
			J +					1175011 4010.55	0.2011		V / T
лцаны.											
права зацицены та	╁										
Bce npat u dama											
Россия Ве Подп. и .											
<u> </u>											
лдт.											
ооктир 3. Nº ди											
-CUCTIEMBA 9. Nº M	-										
000 "АСКОН. Взам. ини											
	┢										
) 2024 TTG											
гия ©. и дат											
хя вер. Тодп.											
v23 Унетная версия одл. Подл. и б					_						
N V23 nodn.											
146-30 146. N° 11			\blacksquare			=	1/4/,	11.03.03.25.0	66245		71 /lucm
2	M3N		בוח	<i>№ докцм.</i> п использования		та	Копиров			.ОО	A4 4